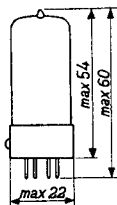
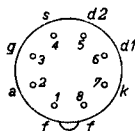
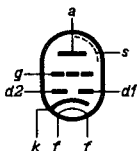


DUODIODE-TRIODE for use as A.F. amplifier
 DUODIODE-TRIODE pour l'utilisation comme amplifica-
 trice B.F.
 DUODIODE-TRIODE zur Verwendung als NF-Verstärker

Heating: indirect by A.C. or D.C.;
 parallel supply
 Chauffage: indirect par C.A. ou C.C.; $V_f = 6,3 \text{ V}$
 alimentation en parallèle $I_f = 0,23 \text{ A}$
 Heizung: indirekt durch Wechsel-
 oder Gleichstrom;
 Parallelspeisung

Dimensions in mm
 Dimensions en mm
 Abmessungen in mm



Base, culot, Fuss: Rimlock

Capacitances	Triode section	Diode section
Capacités	Partie triode	Partie diode
Kapazitäten	Triodenteil	Diodenteil
	$C_g = 2,7 \text{ pF}$	$C_{d1} = 0,8 \text{ pF}$
	$C_a = 1,7 \text{ pF}$	$C_{d2} = 0,7 \text{ pF}$
	$C_{ag} = 1,5 \text{ pF}$	$C_{d1d2} < 0,3 \text{ pF}$
	$C_{gf} < 0,05 \text{ pF}$	$C_{d1f} < 0,1 \text{ pF}$
		$C_{d2f} < 0,05 \text{ pF}$

Between triode and diode sections
 Entre les parties triode et diode
 Zwischen Trioden- und Diodenteilen

$C_{d1g} < 0,007 \text{ pF}$
$C_{d2g} < 0,03 \text{ pF}$
$C_{d1a} < 0,01 \text{ pF}$
$C_{d2a} < 0,01 \text{ pF}$

Typical characteristics of the triode section
 Caractéristique types de la partie triode
 Kenndaten des Triodenteiles

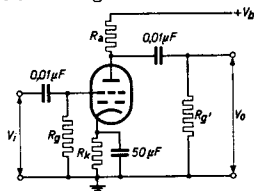
V_a	=	250 V
V_g	=	-3 V
I_a	=	1,0 mA
S	=	1,2 mA/V
μ	=	70
R_i	=	58 k Ω
$R_{eq}(A.F.; B.F.; NF)$	= max.	150 k Ω

Operating characteristics as A.F. amplifier
 Caractéristiques d'utilisation en amplificateur B.F.
 Betriebsdaten als NF-Verstärker

This valve can be used without special precautions against microphonic effect in circuits in which the input voltage $V_i \geq 10$ mV for an output of 50 mW of the output valve

Ce tube peut être utilisé sans précautions spéciales contre l'effet microphonique dans des circuits dont la tension d'entrée $V_i \geq 10$ mV pour une puissance de 50 mW du tube de sortie

Diese Röhre darf ohne spezielle Massnahmen gegen Mikrophonie verwendet werden in Schaltungen die für eine Eingangsspannung $V_i \geq 10$ mV eine Leistung von 50 mW der Endröhre ergeben



$V_b = 250$ V

R_a ($M\Omega$)	R_k ($k\Omega$)	R_g ($M\Omega$)	$R_{g'}$ ($M\Omega$)	I_a (mA)	V_o V_i	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=5V_{eff}$)	$d_{tot} (\%)$ ($V_o=10V_{eff}$)
0,22	1,8	1	0,68	0,70	51	0,55	0,9
0,1	1,2	1	0,33	1,15	43	0,6	1,1
0,22	0	22	0,68	0,76	52	0,5	0,8
0,1	0	22	0,33	1,40	44	0,7	0,9

Limiting values of the triode section
Caractéristiques limites de la partie triode
Grenzdaten des Triodenteiles

V_{ao}	= max. 550 V
V_a	= max. 300 V
W_a	= max. 0,5 W
I_k	= max. 5 mA
$-V_g(I_g=+0,3 \mu A)$	= max. 1,3 V
R_g	= max. 3 M Ω ¹⁾
V_{kf}	= max. 100 V
R_{kf}	= max. 20 k Ω

Limiting values of the diode sections (each diode)
Caractéristiques limites des parties diode (par diode)
Grenzdaten der Diodenteile (pro Diode)

$V_d \text{ invp}$	= max. 350 V
I_d	= max. 0,8 mA
I_{dp}	= max. 5 mA
V_{kf}	= max. 100 V
R_{kf}	= max. 20 k Ω

For curves refer to type EBC81
Pour les courbes voir type EBC81
Für die Kennlinien siehe Typ EBC81

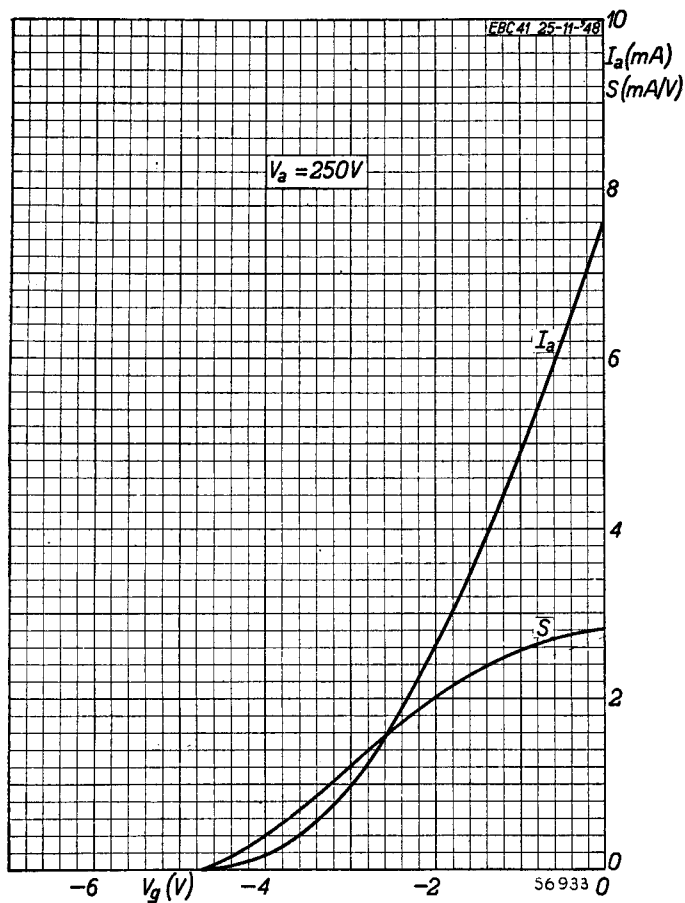
¹⁾ If the grid bias is obtained only by connecting a leakage resistor in the grid circuit, the max. value of R_g is 22 M Ω

Si la polarisation négative est obtenue seulement par moyen d'une résistance de fuite dans le circuit de la grille, la valeur maximum de R_g est de 22 M Ω

Wenn die negative Gittervorspannung nur mittels eines Ableitwiderstandes in der Gitterleitung erhalten wird, ist der Maximalwert von R_g 22 M Ω

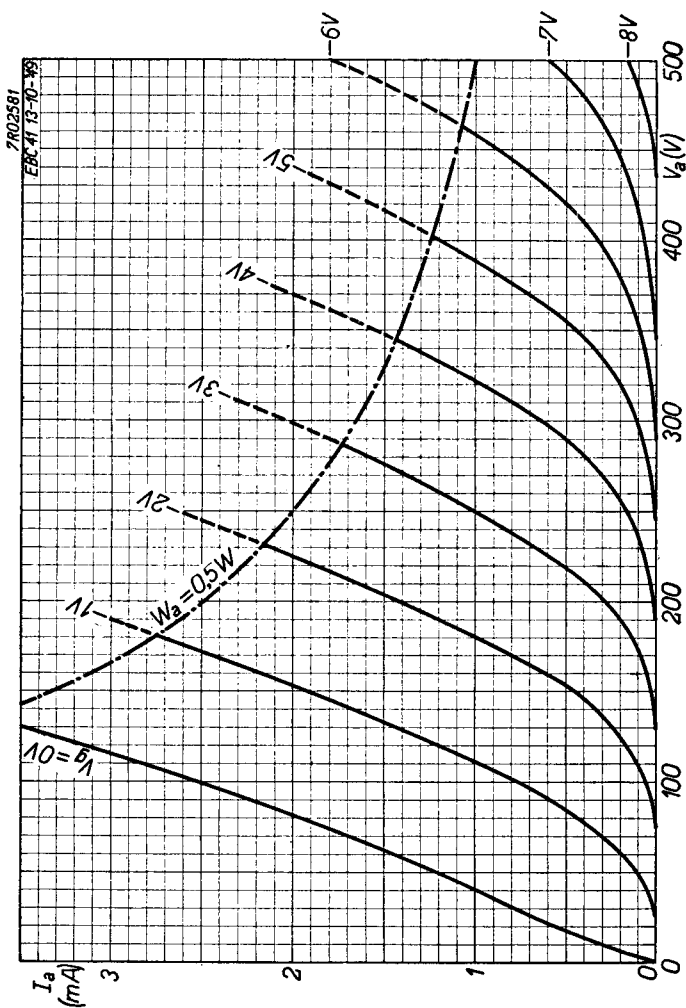
PHILIPS

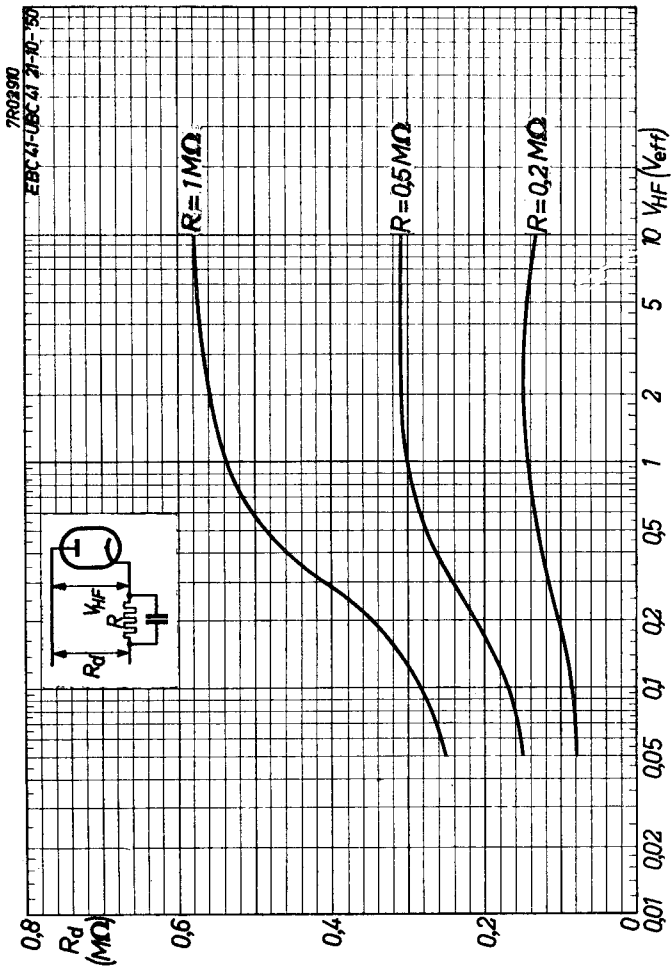
EBC 41



10.10.1949

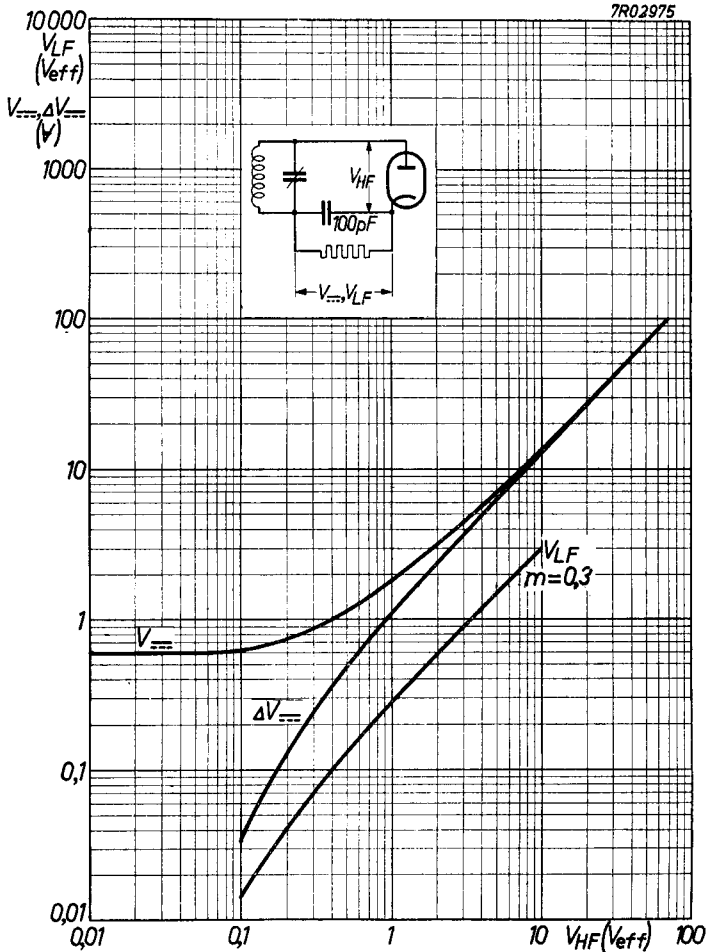
A

EBC 41**PHILIPS**



EBC 41**PHILIPS**

7R02975





	EBC41	
page	sheet	date
1	1	1953.10.10
2	2	1953.10.10
3	3	1958.02.02
4	A	1949.10.10
5	B	1949.10.10
6	C	1950.12.12
7	D	1950.12.12
8	FP	1999.06.14